

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: SESCOSEM

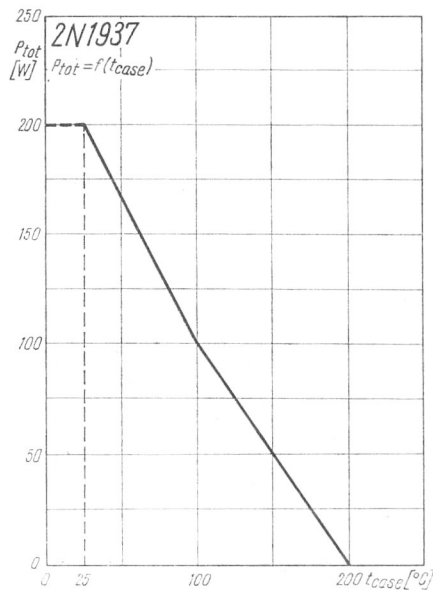
Wykonanie: tranzystor krzemowy dyfuzyjny mesa *n-p-n* w obudowie metalowej TO-63, kolektor połączony z obudową

Zastosowanie: wzmacniacze m.cz. dużych sygnałów, układy przełączające dla dużych prądów

Rys. 1-1156. 2N1937

Wartości charakterystyczne<sup>1)</sup>

	min	max		
$I_{CEX}$		10	mA	przy $U_{BE} = -1$ V, $U_{CE} = 120$ V
$I_{CEX}$		10	mA	przy $U_{BE} = -1$ V, $U_{CE} = 80$ V, $t_{case} = 150^\circ\text{C}$
$I_{CEO}$		15	mA	przy $I_B = 0$ , $U_{CE} = 50$ V
$I_{EBO}$		1	mA	przy $I_C = 0$ , $U_{EB} = 6$ V
$U_{(BR)CEO}^{2)}$	80		V	przy $I_B = 0$ , $I_C = 200$ mA
$h_{21E}^{2)}$	12	75		przy $I_C = 1$ A, $U_{CE} = 3$ V
$h_{21E}^{2)}$	7	50		przy $I_C = 10$ A, $U_{CE} = 3$ V
$h_{21E}^{2)}$	10	50		przy $I_C = 10$ A, $U_{CE} = 10$ V
$h_{21E}^{2)}$	6			przy $I_C = 10$ A, $U_{CE} = 10$ V, $t_{case} = -55^\circ\text{C}$
$U_{BE}^{2)}$		1,25	V	przy $I_C = 10$ A, $U_{CE} = 3$ V
$U_{CE sat}^{2)}$		0,75	V	przy $I_C = 10$ A, $I_B = 1,6$ A
$U_{BE sat}^{2)}$		1,5	V	przy $I_C = 10$ A, $I_B = 1,6$ A
$h_{21c}$	15	90		przy $I_C = 1$ A, $U_{CE} = 10$ V, $f = 1$ kHz
$f_T$	4		MHz	przy $I_C = 1$ A, $U_{CE} = 10$ V, $f = 1$ MHz
$C_{22b}$		1800	pF	przy $U_{CB} = 10$ V, $I_E = 0$ , $f = 1$ MHz



Wartości graniczne<sup>1)</sup>

$U_{CBO}$ max	125	V
$U_{CEO}$ max	80	V
$U_{EBO}$ max	6	V
$I_C$ max	20	A
$I_B$ max	10	A
$P_{tot}$ max	200	W
$t_j$ max	200	$^\circ\text{C}$
$R_{th j-c}$ max	13)	$^\circ\text{C/W}$
$t_{stg}$	-65 ÷ +200	$^\circ\text{C}$

<sup>1)</sup>  $t_{case} = 25^\circ\text{C}$

<sup>2)</sup> pomiar impulsem  $t_p = 300 \mu\text{s}$ ,  $\delta \leq 2\%$

<sup>3)</sup>  $t_{case} \geq 100^\circ\text{C}$

Rys. 1-1157. Zależność całkowitej mocy strat od temperatury otoczenia